

**Thesis Title** Phase Transition in Normal and Relaxor Ferroelectric Materials

**Author** Miss Nattaya Tawichai

**Degree** Doctor of Philosophy (Materials Science)

**Thesis Advisory Committee**

Assoc. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul	Advisor
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri	Co-advisor
Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontrakoon	Co-advisor
Asst. Prof. Dr. Kamonpan Pengpat	Co-advisor

**ABSTRACT**

Ferroelectric materials have been widely studied for various applications. Among many different types of ferroelectric materials,  $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Sn}_x)\text{O}_3$  (BTS) has been shown to possess very good characteristics against electric field and tunable properties. With varying Sn content, this material can exhibit either a normal ferroelectric or relaxor behavior. Therefore, it has attracted great attention recently.

In the present work, lead-free ceramics of  $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.9}\text{Sn}_{0.1})\text{O}_3$ : BTS10 with  $\text{B}_2\text{O}_3$  addition were prepared by a conventional solid state sintering method. The various amounts of  $\text{B}_2\text{O}_3$  (0.5, 1.0, 2.0 and 3.0 wt.%) were mixed in BTS10 powder and

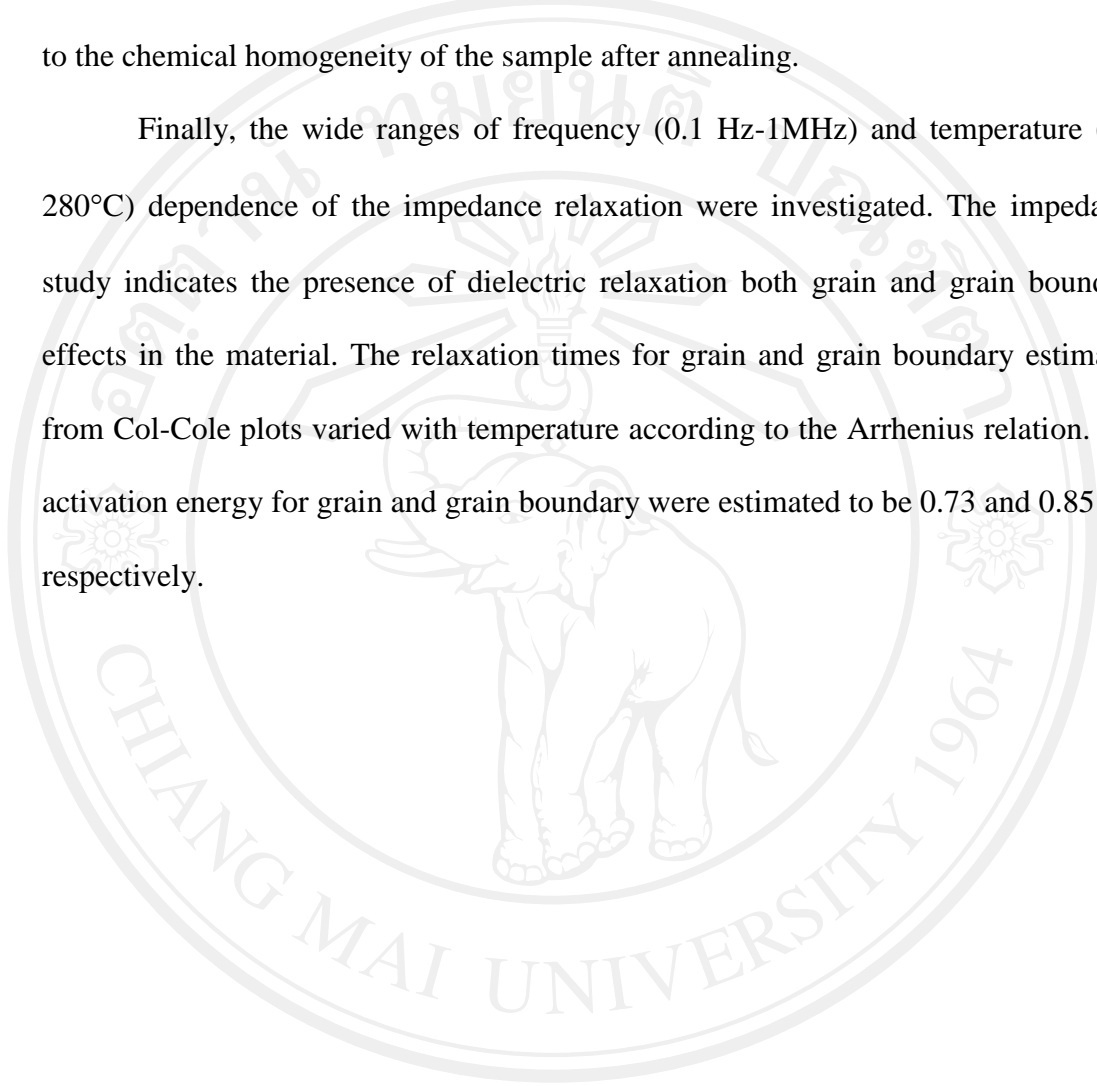
sintered with different temperatures. Dielectric and piezoelectric properties of the ceramics were investigated as a function of sintering temperature. Although density of the ceramics was observed to decrease with increasing the sintering temperature, the sample sintered at 1350°C showed maximum dielectric constant of 13900 at the phase transition temperature ~36°C. Higher relative tunability of 83% was also observed at the same condition. But, the ceramics showed a lower piezoelectric coefficient ( $d_{33}$ ) at a higher sintering temperature.

The phase transition and electrical properties of  $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.9}\text{Sn}_{0.1})\text{O}_3$  ceramics with  $\text{B}_2\text{O}_3$  added were investigated to explore the effect of  $\text{B}_2\text{O}_3$  addition on enhanced densification and dielectric constant of these ceramics. With increasing  $\text{B}_2\text{O}_3$  content, a linear reduction of ferroelectric to paraelectric transition temperature was observed. In addition, higher  $\text{B}_2\text{O}_3$  concentrations enhanced a ferroelectric relaxor behavior in the ceramics. Changes in this behavior were related to densification, second-phase formation and compositional variation of the ceramics.

Moreover, the posted sintered annealing method was applied for  $\text{B}_2\text{O}_3$  doped  $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.9}\text{Sn}_{0.1})\text{O}_3$  ceramics. The ceramics were fabricated via a solid state reaction method: sintered at 1350°C for 24h followed by annealing at 1100°C for 4-32 h. Many electrical properties of the ceramics annealed at various annealing times were investigated with a variety of methods. Annealing for 4h produced a sharper phase transition with high dielectric constant. The high dielectric constant of 27,000 was recorded at ferroelectric to paraelectric phase transition temperature of 38°C. This sample also showed a high dielectric tunability of 70%. Ferroelectric performance of

the sample was also improved. The improvements in electrical properties were related to the chemical homogeneity of the sample after annealing.

Finally, the wide ranges of frequency (0.1 Hz-1MHz) and temperature (20-280°C) dependence of the impedance relaxation were investigated. The impedance study indicates the presence of dielectric relaxation both grain and grain boundary effects in the material. The relaxation times for grain and grain boundary estimated from Col-Cole plots varied with temperature according to the Arrhenius relation. The activation energy for grain and grain boundary were estimated to be 0.73 and 0.85 eV, respectively.



ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนวัฏภาคในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบปริแลกเซอร์

ผู้เขียน นางสาวณัฐยา ต๊ะวิไชย

ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ศ.ดร.ทวี ตันฉศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

รศ.ดร.จิระพงษ์ ตันตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผศ.ดร.กมลพรรณ เฟื่องพัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การศึกษาสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปอย่างแพร่หลาย จากจำนวนสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีมากมายหลายกลุ่ม แบเรียมสแทนเนตทิตานเนต  $Ba(Ti_{1-x}Sn_x)O_3$  เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่แสดงสมบัติเฉพาะและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่ติภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า วัสดุนี้นี้สามารถแสดงพฤติกรรมของทั้งสารเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบปริแลกเซอร์ตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีบุก ซึ่งทำให้สารชนิดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในงานนี้ ได้ทำการเตรียมเซรามิกปลอดสารตะกั่วในระบบ  $Ba(Ti_{0.9}Sn_{0.1})O_3$  หรือเรียกว่า BTS10 ที่เจือด้วยออกไซด์ของโบรอน ด้วยวิธีผสมของแข็งแบบดั้งเดิม ผสมกับผงออกไซด์ของโบรอน ในปริมาณร้อยละ 0.5 1.0 2.0 และ 3.0 โดยน้ำหนัก และทำการเผาผนึกด้วยอุณหภูมิต่างๆกัน จากนั้นศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกและไพโซอิเล็กทริกของเซรามิกที่ได้เทียบกับอุณหภูมิเผาผนึก พบว่าค่าความหนาแน่นของเซรามิกลดลงเมื่ออุณหภูมิเผาผนึกสูงขึ้น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดที่ 13900 พบได้ในชิ้นงานที่เผาผนึกด้วยอุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมิการ

เปลี่ยนวัฏภาคที่ประมาณ 36 องศาเซลเซียส ค่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้สัมพัทธ์ (relative tunability) มีค่าสูงสุดร้อยละ 83 ในชิ้นงานที่เผาผนึกด้วยอุณหภูมิเดียวกัน แต่ค่าสัมประสิทธิ์โพธิโซอิเล็กทริก ( $d_{33}$ ) มีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเผาผนึกสูงขึ้น

เมื่อศึกษาการเปลี่ยนวัฏภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกพลอดสารตะกั่วในระบบ  $Ba(Ti_{0.9}Sn_{0.1})O_3$  เปลี่ยนแปลงตามปริมาณออกไซด์ของโบรอน พบว่าการเติมออกไซด์ของโบรอน กระตุ้นให้เกิดการแน่นตัวของเซรามิกมากขึ้น นอกจากนี้ปริมาณออกไซด์ของโบรอนที่เพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนวัฏภาคจากเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกลดลงแบบเชิงเส้น นอกจากนี้ปริมาณออกไซด์ของโบรอนที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแบบรีแลกเซอร์ในเซรามิก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สัมพันธ์กับค่าความหนาแน่น การเกิดวัฏภาคที่สองและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในเซรามิกพลอดสารตะกั่วในระบบ  $Ba(Ti_{0.9}Sn_{0.1})O_3$

นอกเหนือจากอุณหภูมิเผาผนึกและปริมาณออกไซด์ของโบรอนที่มีผลต่อเซรามิกแล้ว กระบวนการอบอ่อนหลังการเผาผนึกมีผลเป็นอย่างมากต่อเซรามิกพลอดสารตะกั่วในระบบ  $Ba(Ti_{0.9}Sn_{0.1})O_3$  เซรามิกที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4-32 ชั่วโมง เมื่อทำการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่ผ่านการอบอ่อนพบว่า ชิ้นงานที่ผ่านการอบอ่อนเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง ทำให้เกิดการเปลี่ยนวัฏภาคอย่างฉับพลันและทำให้ชิ้นงานมีค่าไดอิเล็กทริกสูง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดที่ 27000 พบ ณ อุณหภูมิการเปลี่ยนวัฏภาคจากเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกที่ประมาณ 38 องศาเซลเซียส ค่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้สัมพัทธ์ มีค่าสูงสุดร้อยละ 70 ในชิ้นงานที่ผ่านการอบอ่อนด้วยเงื่อนไขเดียวกัน การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าสัมพันธ์กับความเป็นเนื้อเดียวกันขององค์ประกอบทางเคมีของชิ้นงานที่ผ่านการอบอ่อน

ในตอนท้าย ได้ทำการตรวจสอบอิมพีแดนซ์รีแลกเซชันของเซรามิกพลอดสารตะกั่วในระบบ  $Ba(Ti_{0.9}Sn_{0.1})O_3$  เทียบกับความถี่ในช่วง 0.1 เฮิรซ์ ถึง 1 เมกะเฮิรซ์ และอุณหภูมิระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ถึง 280 องศาเซลเซียส พบว่าเกิดไดอิเล็กทริกรีแลกเซชันทั้งในเกรนและขอบเกรน เวลาที่เกิดรีแลกเซชันในเกรนและขอบเกรนสามารถประมาณได้จากกราฟ Cole-Cole ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและเป็นไปตามความสัมพันธ์ของอาร์เรเนียส (Arrhenius relation)

พลังงานก่อกัมมันต์ (Activation energy) ของเกรนและขอบเกรนมีค่าประมาณ 0.73 และ 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved